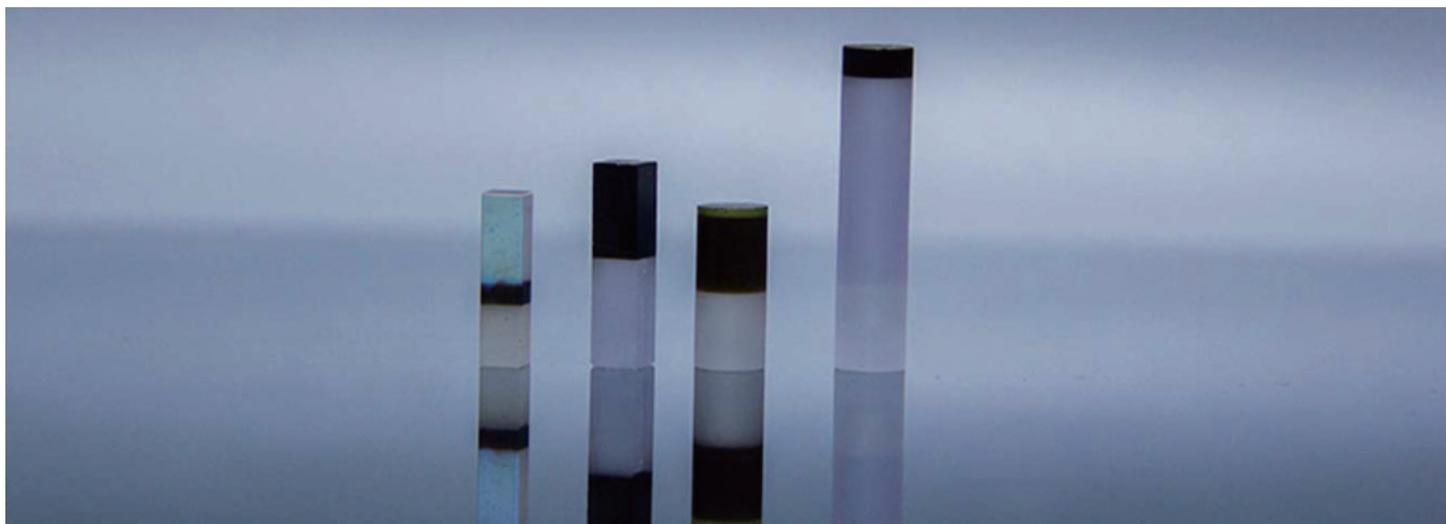


YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄



描述

我司YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄键合晶体，是Nd:YVO₄两端键合纯YVO₄形成的键合晶体，可以有效的改善Nd:YVO₄激光的综合性能。

Nd:YVO₄的热导率为11.7W/cm/°K@ 25°C，纯YVO₄晶体的热导率为：5.23 W/m/K@//C；5.10 W/m/K@⊥C，两端键合形成YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄键合晶体，可以有效改善Nd:YVO₄晶体的热效应，降低激光泵浦时形成的热透镜效应，改善激光的光束质量，提升457nm、671nm激光输出效率，并能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命。

上海芯飞睿使用表面活化键合技术，是一种低温或者常温下的键合技术，典型特征是表面清洗和表面活化。在键合前，通过快原子或者离子束对键合表面的轰击，可以有效的增加键合强度，实现对无机材料、金属、半导体材料间的高质量键合。与高温热键合方法相比，表面活化键合技术键合结合力界面较高、光吸收损耗和面形变化控制相对而言更优，而热扩散键合表面的杂质去不掉，被键合在结合面。表面活化键合技术有去除各种抛光的残留成分、去除有机污染物、去除表面氧化层和打断材料化学键，提升活化能等优点。

生产的YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄键合晶体的键合强度高、键合面吸收损耗小（一般小于20ppm）、键合面面形变化小（键合后面形<λ/8）。键合晶体的形状可以是棒状、板状、波导或者三明治形状。在键合晶体两端可以提供多种类型的镀膜，如两个端面增透膜AR@1064nm+808nm，或者S1:HR@1064nm&AR@808nm，S2:PR@1064nm&HR@808nm等。YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄键合晶体广泛用于在机械、材料加工、波谱学、晶片检验、显示器、医学检测、激光印刷、数据存储等多个领域。

特点

- 有效改善Nd:YVO₄晶体的热效应
- 降低激光泵浦时形成的热透镜效应
- 改善激光的光束质量
- 提升457nm、671nm激光输出效率
- 能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命

应用

- 口腔治疗领域的人性化
- 全息，干涉，光存储等领域
- 激光切割和焊接
- 激光雷达和光学制冷
- 超短脉冲研究
- 材料微加工
- 多光子显微镜



YVO₄+Nd:YVO₄+YVO₄

参数

YVO ₄ +Nd:YVO ₄ +YVO ₄			
Materials	YVO ₄	Nd:YVO ₄	YVO ₄
concentrations	/	0.5%,1%, 2%,2,5%, 3%	
Structure	Rods/Slabs/Sandwich/Waveguide/		
End-face Configuration	Flat/Convex/Wedge		
Side Configuration	Polish/Fine Ground		
Coating available	AR@1064nm+808nm	/	AR@1064nm+808nm
	HR@1064nm&AR@808nm	/	PR@1064nm&HR@808nm
	others	/	others



有什么问题请联系我们的
技术工程师，在线为
您解答



了解更多资讯，请关注
我们的公众号--上海芯
飞睿科技有限公司

